УДК 538.971

МЕЖФАЗНАЯ ЭНЕРГИЯ ГРАНЕЙ КРИСТАЛЛОВ НА-МЕТАЛЛОВ НА ГРАНИЦЕ С НЕПОЛЯРНОЙ ОРГАНИЧЕСКОЙ ЖИДКОСТЬЮ С УЧЕТОМ ДИСПЕРСИОННОЙ И ПОЛЯРИЗАЦИОННОЙ ПОПРАВОК

© 2019 г. А. М. Апеков^{1,} *, И. Г. Шебзухова^{2,} **

¹Институт прикладной математики и автоматизации филиал Федерального государственного бюджетного научного учреждения "Федеральный научный центр "Кабардино-Балкарский научный центр Российской академии наук", Нальчик, Россия ²Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Кабардино-Балкарский государственный университет имени Х.М. Бербекова", Нальчик, Россия

*E-mail: aslkbsu@yandex.ru **E-mail: irina.shebzukhova@mail.ru Поступила в редакцию 20.11.2018 г. После доработки 16.12.2018 г. Принята к публикации 25.02.2019 г.

Установлено влияние органической жидкости на ориентационную зависимость поляризационной и дисперсионной поправок к межфазной энергии IIA-металлов и получена межфазная энергия граней металлических кристаллов с учетом этих поправок в рамках электронно-статистического метода. Показана зависимость межфазной энергии от атомного номера элемента и концентрации частиц на грани.

DOI: 10.1134/S0367676519060073

В настоящее время широкое практическое применение получают металлоорганические структуры [1]. Особенности границы раздела металл-органика позволяют создавать материалы, обладающие практически полезными свойствами, используемыми в катализе [2], хранении энергии, электронике [3], хранении и разделении газов [4, 5], магнетизме, нелинейной оптике и т.д. [6–12].

Изучение физико-химических свойств границы раздела контактирующих фаз является актуальной задачей. Одной из основных характеристик границ раздела фаз является межфазная энергия (МЭ). В работах [13–15] исследовалось влияние поляризации на свойства металлоорганических структур, установлено [16] влияние поляризации металлических ионов переходного слоя и поляризации жидкости в поле полубесконечного металла на границе металл-органическая жидкость на МЭ граней металлического кристалла. В работах [17-21] нами развита электронностатистическая теория МЭ на границе металлнеполярная органическая жидкость с учетом квантовых поправок. В настоящей работе в рамках этой теории получены поляризационный и дисперсионный вклады в МЭ и уточнена МЭ граней кристаллов ПА-металлов на границе с неполярными органическими жидкостями с учетом этих вкладов.

Поляризационная поправка к МЭ определяется внутренним и внешним вкладами:

$$f_{\omega_{12}}^{p}(hkil) = f_{\omega_{12}}^{pl}(hkil) + f_{\omega_{12}}^{pe}(hkil).$$
(1)

Внутренний вклад $f_{\omega_1}^{pi}(hkil)$ в поправку к МЭ связан с поляризацией металлических ионов переходного слоя [16]:

$$f_{\omega l2}^{pi}(hkil) = -\frac{\alpha V_F^2 n^2}{2s^2 b^2} \frac{(1-\chi(0,\varepsilon))^2}{\lambda^2} \times \left[\left(1 - \frac{r + x_{\Gamma}(\varepsilon)}{bs\lambda}\right)^{-2(n+1)} + \left(1 - \frac{r + x_{\Gamma}(\varepsilon) + \delta(hkil)}{bs\lambda}\right)^{-2(n+1)} \right] n(hkil),$$

$$(2)$$

а внешний вклад $f_{\omega l 2}^{pe}(hkil)$ – с поляризацией органической жидкости в поле полубесконечного металла [16]:

$$f_{\omega l 2}^{pe}(hkil) = -\frac{2V_F^2}{3\pi} \frac{\chi^2(0,\varepsilon)}{sb\lambda^9} \left(1 + \frac{r + x_\Gamma(\varepsilon)}{b\lambda s}\right)^{-9} \times \\ \times \frac{S^{\mu}}{N} \left[1 + \frac{18\chi^2(0,\varepsilon)}{15\pi b^2\lambda^{10}} \left(\frac{V_F}{s}\right)^2 \left(1 + \frac{r + x_\Gamma(\varepsilon)}{b\lambda s}\right)^{-10} U\right] \times (3) \\ \times \frac{\mu}{d} \frac{(\varepsilon - 1)}{(\varepsilon + 2)} n(hkil),$$

где α – поляризуемость металла; V_F – потенциал Ферми; *s* – параметр, приводящий уравнение Томаса–Ферми к безразмерному виду; λ – вариационный параметр. минимизирующий поверхностную энергию металла при учете обменной поправки; $\chi(0,\epsilon)$ — безразмерный потенциал на физической поверхности раздела; $x_{\Gamma}(\varepsilon)$ – коорлината гиббсовой поверхности раздела: *n* и *b* – параметры безразмерного потенциала (являются функциями диэлектрической проницаемости є органической жидкости); *г* и *R* – радиусы металлического иона и *s*-сферы; $\delta(hkil)$ – межплоскостное расстояние; n(hkil) — концентрация частиц на грани металлического кристалла; $S^{(M)} = f N^{1/3} \left(\frac{A}{D}\right)^{2/3};$ f – множитель, зависящий от координационного числа металлического кристалла; А и D – атомный вес и плотность металла; *N* – число Авога-

дро: *U* учитывает электрострикционный эффект: и и d – молярная масса и плотность органической жилкости. Поправка к МЭ границы грань металлическо-

го кристалла-неполярная органическая жидкость на дисперсионное взаимодействие *s*-сфер в переходном слое получена с учетом флуктуационной теории Лифшица [22, 23] в виде [24]:

$$f_{\omega l2}^{g}(hkil) \approx 12.115 f\left(\frac{A}{ND}\right)^{2/3} \times \frac{\hbar (z/\gamma)^{1/2}}{R^{7/2} \left(1 - \frac{r + x_{\Gamma}}{R}\right)^{2}} n(hkil),$$
(4)

где *ћ* – постоянная Планка; *z* – число свободных электронов на атом, $\gamma = m^*/m$, $m^* - эффективная$ масса электрона, *т* – масса свободного электрона.

По формулам (1)-(4) рассчитаны поляризационная и дисперсионная поправки к МЭ граней кристаллов IIА-металлов с различными кристаллическими структурами – ГПУ (для α-бериллия и магния), ГЦК (для α-кальция и α-стронция) и ОЦК (для бария) на границе с неполярными органическими жидкостями с диэлектрической проницаемостью $\varepsilon = 1.8 - 2.5$.

На рис. 1 показаны зависимости внутреннего и внешнего вкладов в поляризационную поправку к МЭ базисной грани кристаллов низкотемпературной модификации бериллия (α-бериллия) (рис. 1a) и магния (рис. 1b) от диэлектрической проницаемости органической жидкости. Как видно, с увеличением диэлектрической проницаемости ($\epsilon = 1.8 - 2.5$) внутренний вклад линейно увеличивается, а внешний слабо зависит от диэлектрической проницаемости жидкости. Подобное имеет место и для других металлов (α-кальция, α-стронция и бария).

Дисперсионная поправка к МЭ граней кристаллов IIА металлов вносит положительный вклад в МЭ, и с увеличением диэлектрической проницаемости неполярной органической жидкости величина дисперсионной поправки уменьшается.

На рис. 2 показаны зависимости поляризационной (рис. 2*a*) и дисперсионной (рис. 2*б*) поправок к МЭ граней кристаллов магния от диэлектрической проницаемости органической жидкости. Как видно, с увеличением диэлектрической проницаемости (є = 1.8–2.5) поляризационная поправка к МЭ граней (0001), (11 $\overline{2}$ 0), (10 $\overline{1}$ 0) и $(11\overline{2}1)$ по модулю линейно уменьшаются. Ориен-



вкладов в поляризационную поправку к межфазной энергии грани (0001) α-бериллия (а) и магния (б) от

диэлектрической проницаемости органической жид-

кости.



a



Рис. 2. Зависимость поляризационного (*a*) и дисперсионного (*б*) вкладов в межфазную энергию граней кристаллов магния от диэлектрической проницаемости органической жидкости.

тационная зависимость дисперсионной поправки к МЭ магния показывает (рис. 2 б), что $f_{\omega l 2}^{g}(0001) > f_{\omega l 2}^{g}(11\overline{2}0) > f_{\omega l 2}^{g}(10\overline{1}0) > f_{\omega l 2}^{g}(11\overline{2}1).$

Межфазные энергии граней IIА-металлов на границе с органическими жидкостями с учетом поляризационной и дисперсионной поправок рассчитаны по формуле

$$f_{\omega l2}(hkil) =$$

$$= f_{\omega l2}^{T}(hkil) + f_{\omega l2}^{p}(hkil) + f_{\omega l2}^{g}(hkil), \qquad (5)$$

где $f_{\omega l2}^{T}(hkil)$ — межфазные энергии граней с малыми индексами Миллера с учетом квантовой, осцилляционной поправок и температурной зависимости [17–21]. По формуле (5) проведена



Рис. 3. Зависимость МЭ металлов IIA от атомного номера элемента (a) и зависимость МЭ бериллия на границе с органическими жидкостями от концентрации частиц на грани (δ).

оценка МЭ граней кристаллов низкотемпературных модификаций бериллия, кальция, стронция и кристаллов магния и бария на границе с неполярными органическими жидкостями.

На рис. За представлена зависимость МЭ базисных граней ПА-металлов на границе с толуолом от атомного номера элемента. Как видно, с увеличением атомного номера элемента в группе значение МЭ уменьшается. С увеличением концентраций частиц на грани кристалла α -бериллия МЭ возрастает (рис. Зб), а с увеличением макроскопической диэлектрической проницаемости МЭ уменьшается. Результаты вычислений показывают, что поляризационная поправка снижает МЭ разных граней кристаллов на границе с рассматриваемыми органическими жидкостями (α -бериллия на 6-8%, магния на 1-23%, α -кальция и α -стронция на 11-12% и бария на 8-20%), а дисперсионная увеличивает и составляет 3-8% от МЭ α -кальция (α -стронция и магния), 11-16% от МЭ α -бериллия (бария).

Ориентационная зависимость МЭ показывает, что для кристаллов со структурами ГПУ (α -бериллий и магний) – $f_{\omega l_2}(0001) > f_{\omega l_2}(10\overline{10}) > f_{\omega l_2}(11\overline{20}) > f_{\omega l_2}(11\overline{21})$, ГЦК (α -кальций и α -стронций) – $f_{\omega l_2}(111) > f_{\omega l_2}(100) > f_{\omega l_2}(110)$, и ОЦК (барий) – $f_{\omega l_2}(110) > f_{\omega l_2}(100) > f_{\omega l_2}(111)$.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В рамках электронно-статистического метода получена ориентационная зависимость поляризационной и дисперсионной поправок к МЭ кристаллов IIA металлов со структурами гексагональной плотноупакованной (α-бериллия, магния). гранецентрированной кубической (α-кальций, αстронций) и объёмноцентрированной кубической (барий) на границе с неполярными органическими жидкостями ($\varepsilon = 1.8 - 2.5$) и уточнены МЭ граней кристаллов IIA металлов с учетом этих поправок. Показано, что поляризационная поправка к МЭ металлов и ее вклады отрицательны. Вклад, связанный с поляризацией металлических ионов в переходном слое для граней кристаллов рассматриваемых металлов, практически линейно возрастает с увеличением диэлектрической проницаемости жидкости, а поляризация органической жидкости в поле полубесконечного металла дает вклад слабо зависящий от диэлектрической проницаемости. Дисперсионное взаимодействие sсфер вносит положительный вклад в МЭ, и увеличение диэлектрической проницаемости органической жидкости приводит к уменьшению дисперсионной поправки. Межфазные энергии граней кристаллов IIА металлов на границе с неполярными органическими жидкостями, полученные с учетом квантовой, осцилляционной, поляризационной и дисперсионной поправок при T = 293 K, уменьшаются по сравнению с поверхностной энергией граней этих металлов на границе с собственным паром. С увеличением атомного номера элемента в группе значения МЭ уменьшается. С увеличением концентраций частиц на грани кристалла МЭ возрастает.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

 Czaja A.U., Trukhan N., Müller U. // Chem. Soc. Rev. 2009. V. 38. № 5. P. 1284.

- Seo J.S., Whang D., Lee H. et al. // Nature. 2000. V. 404. P. 982.
- Liu Z., Kobayashi M., Paul B.C. // Phys. Rev. B. 2010.
 V. 82. № 3. Art. № 035311.
- Mendoza-Cortes J.L., Han S.S., Goddard W.A. // Phys. Chem. A. 2012. V. 116. P. 1621.
- Furukawa H., Ko N., Go Y.B. // Science. 2010. V. 329. P. 424.
- 6. Бутова В.В., Солдатов М.А., Гуда А.А. и др. // Усп. хим. 2016. Т. 85. С. 280.
- Stroppa A., Barone P., Jain P. // Adv. Mater. 2013. V. 25. № 16. P. 2284.
- 8. Ferrey G. // Chem. Soc. Rev. 2008. V. 37. № 1. P. 191.
- 9. Yablonovitch E. // Phys. Rev. Lett. 1987. V. 58. P. 2059.
- 10. Gibbons N., Baumberg J. // Phys. Rev. 2012. V. B 85. Art. № 165422.
- 11. *Богданов А.А., Сурис Р.А.* // Письма в ЖЭТФ. 2012. Т. 96. № 1. С. 52.
- 12. Lepeshkin N., Schweinsberg A., Piredda G. // Phys. Rev. Lett. 2004. V. 93. Art. № 123902.
- 13. *Gutmann F., Lyons L.E.* Organic Semiconductors. Ch. 6. New York: Wiley, 1967.
- 14. *Tsiper E.V., Soos Z.G.* // Phys. Rev. B. 2001. V. 64. № 19. Art. № 195124.
- 15. *Di Sante D., Stroppa A., Jain P., Picozzi S.* // J. Am. Chem. Soc. 2013. V. 135. № 48. P. 18126.
- Шебзухова И.Г., Апеков А.М., Хоконов Х.Б. // Изв. РАН. Сер. физ. 2018. Т. 82. № 7. С. 881; Shebzukhova I.G., Apekov A.M., Khokonov Kh.B. // Bull. Russ. Acad. Sci. Phys. 2018. V. 82. № 7. Р. 789.
- Шебзухова И.Г., Апеков А.М., Хоконов Х.Б. // Изв. РАН. Сер. физ. 2014. Т. 78. № 8. С. 1035; Shebzukhova I.G., Apekov А.М., Khokonov Kh.B. // Bull. Russ. Acad. Sci. Phys. 2014. V. 78. № 8. Р. 804.
- Шебзухова И.Г., Апеков А.М., Хоконов Х.Б. // Изв. РАН. Сер. физ. 2015. Т. 79. № 6. С. 826; Shebzukhova I.G., Apekov А.М., Khokonov Kh.B. // Bull. Russ. Acad. Sci. Phys. 2015. V. 79. № 6. Р. 749.
- 19. Шебзухова И.Г., Апеков А.М., Хоконов Х.Б. // Изв. РАН. Сер. физ. 2016. Т. 80. № 6. С. 725; Shebzukhova I.G., Apekov A.M., Khokonov Kh.B. // Bull. Russ. Acad. Sci. Phys. 2016. V. 80. № 6. Р. 657.
- Шебзухова И.Г., Апеков А.М., Хоконов Х.Б. // Изв. РАН. Сер. физ. 2017. Т. 81. № 5. С. 645; Shebzukhova I.G., Apekov A.M., Khokonov Kh. B. // Bull. Russ. Acad. Sci. Phys. 2017. V. 81. № 5. Р. 605.
- Шебзухова И.Г., Апеков А.М., Хоконов Х.Б. // Изв. вузов. Сев.-Кав. рег. Естеств. науки. 2009. № 3. С. 67.
- 22. Лифшиц Е.М. // ЖЭТФ. 1955. Т. 29. С. 94.
- Дзялошинский И.Н., Лифииц Е.М., Питаевский Л.П. // УФН. 1961. Т. 73. № 3. С. 381.
- 24. Шебзухова И.Г., Апеков А.М. // Физико-химические аспекты изучения кластеров, наноструктур и наноматериалов. Межвуз. Сб. науч. тр. / Под ред. В.М. Самсонова, Н.Ю. Сдобнякова. Тверь: Твер. гос. ун-т, 2017. Вып. 9. С. 518.